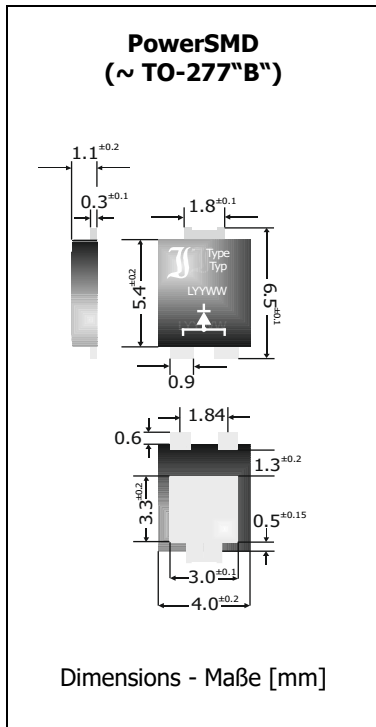


PPS1545-3G ... PPS1560 SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes SMD Schottky-Gleichrichterdioden	I_{FAV} = 15 A V_F < 0.50...0.69 V T_{jmax} = 150°C	V_{RRM} = 45...60 V I_{FSM} = 250/275 A V_{F125} ~ 0.29 V @ 5 A
--	---	--

Version 2019-03-26



Typical Applications

Output Rectification in DC/DC Converters and Offline Power Supplies
Solar Bypass Diodes, Polarity Protection, Free-wheeling diodes
Commercial grade
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification ¹⁾

Features

3rd Generation Schottky (-3G): Best State-of-the-Art V_F & I_R
High power dissipation
Low profile package
Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled 5000 / 13"
Weight approx. 0.1 g
Case material UL 94V-0
Solder & assembly conditions 260°C/10s
MSL = 1



Typische Anwendungen

Ausgangsgleichrichtung in DC/DC Wandlern und Steckernetzteilen
Solar-Bypassdioden, Verpolschutz, Freilaufdioden
Standardausführung
Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation ¹⁾

Besonderheiten

3. Generation Schottky (-3G): Bestes V_F & I_R im Industrievergleich
Hohe Leistungsfähigkeit
Flache Bauform
Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle
Gewicht ca.
Gehäusematerial
Löt- und Einbaubedingungen

Maximum ratings ²⁾

Grenzwerte ²⁾

Type Typ	DC blocking voltage Sperrgleichspannung V _{DC} [V] ³⁾	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V _{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V _{RSM} [V]
PPS1545-3G	–	45	45
PPS1550 (-3G: Q4 2019)	–	50	50
PPS1560 (-3G: Q4 2019)	–	60	60

Max. average forward rectified current Dauergrenzstrom in Einwegschaltung	T _C = 100°C ⁴⁾	I _{FAV}	10 A ⁵⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz T _C = 100°C ⁴⁾	I _{FRM}	50 A ⁵⁾
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung	Half sine-wave Sinus-Halbwellen 50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms)	I _{FSM}	250 A ⁵⁾ 275 A ⁵⁾
Rating for fusing – Grenzlastintegral	t < 10 ms	i ² t	312 A ² s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur ... in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _j T _j T _S	-50...+150°C ≤ 200°C ⁶⁾ -50...+175°C

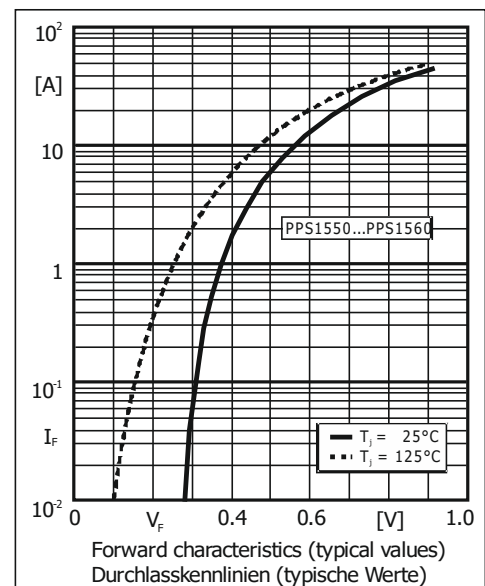
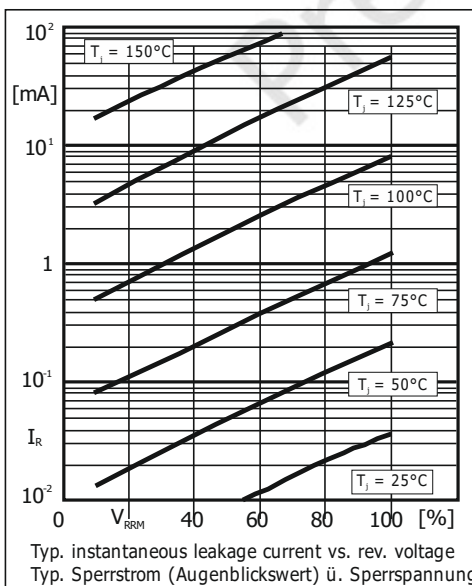
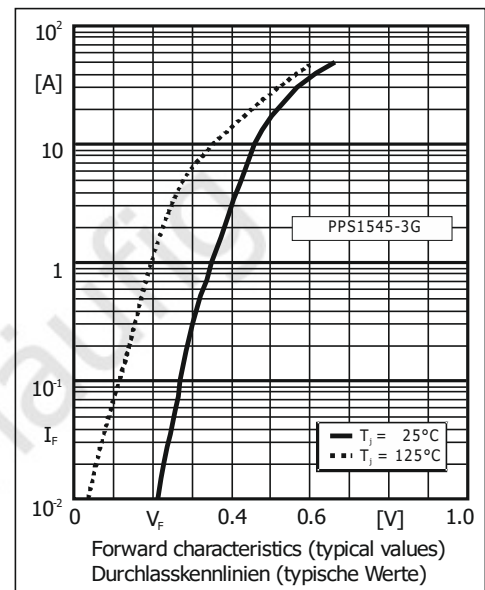
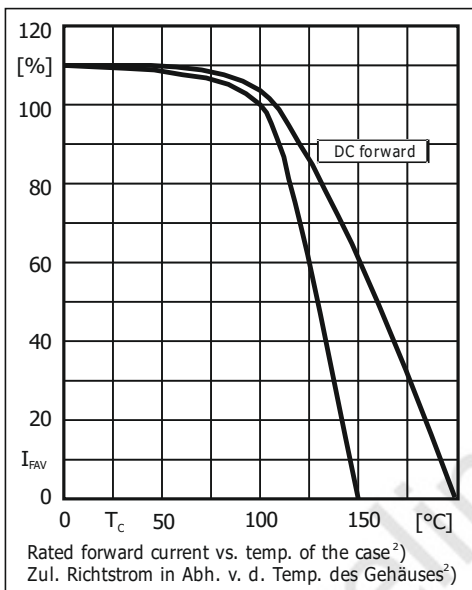
1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
2 T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben
3 Defined for -AQ parts only, T_j = 125°C – Nur definiert für -AQ Bauteile, T_j = 125°C
4 Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlfahne
5 Both anode pins connected – Beide Anodenanschlüsse kontaktiert
6 Meets the Requirements of IEC 61215 bypass diode thermal test, t < 1h
Erfüllt die Anforderungen des IEC 61215 Bypass-Diodentests, t < 1h

Characteristics

Kennwerte

Type Typ	Forward voltage Durchlass-Spannung			Forward voltage Durchlass-Spannung			Forward voltage Durchlass-Spannung		
	V_F [V] ¹⁾	@ I_F [A]	@ T_j	V_F [V] ¹⁾	@ I_F [A]	@ T_j	V_F [V] ¹⁾	@ I_F [A]	@ T_j
PPS1545-3G	typ. 0.29	5	125°C	< 0.425	5	25°C	< 0.50	15	25°C
PPS1550, PPS1560	typ. 0.36	5	125°C	< 0.550	5	25°C	< 0.69	15	25°C

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 150 μA typ. 10 mA
Typical junction capacitance – Typische Sperrschichtkapazität	$V_R = 4\text{ V}$		C_j	720 pF
Typ. thermal resistance junction to case – Typ. Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R_{thC}	2 K/W ²⁾



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Both anode pins connected – Beide Anodenanschlüsse kontaktiert
2 Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlfahne